



师资队伍

师资概况

在岗教师

长江学者

博士后

党建园地

党建动态

GO >>

网上党校

GO >>

文明创建

GO >>

党员风采

GO >>

党纪条例

GO >>

科学研究

科研公共平台共享设备 **HOT**

磁性材料及其应用技术研究... **HOT**

国家自然科学基金项目申报...

信息存储材料及器件研究所... **HOT**

信息存储与智能系统研究中...



教授

NEWS

您现在的位置: 首页 - 师资队伍 - 在岗教师 - 教授



余岳辉

职 称: 教授、博士生导师

学 位: 学士

职 务: 电力电子技术研究所所长

实 验 室: 电力电子技术研究所

Email: yuyuehui@mail.hust.edu.cn

联系电话: 027-87542793

中文简介

1969年7月毕业于华中工学院电机系电器专业, 自1970年以来一直从事电力电子器件及技术的教学和科研工作
1987年7月被聘为副教授
1993年7月晋升为华中理工大学教授
1994.10-1995.4在日本上智大学电气工学科以客员研究员身份作访问研究。

英文简介

Education background:

Received the Bachelor degree in electrical engineering from Huazhong College in 1969.

Professional experience:

Professor Yu Yuehui has attended to researching and teaching on Power Electronics devices from 1970. He was appointed as an Associate Professor in July 1987 and subsequently a Professor in July 1993 of Huazhong University of Science and Technology. He served as a guest research fellow in an electrical engineering at SOPHIA University in Japan from October 1994 to April 1995.

研究方向

大功率半导体器件的设计、制造及应用技术; 半导体脉冲功率开关及技术; 集成功率系统(System On Package)

学术成就和学术兼职

【学术成就】

共承担国家基金和省部级研究项目20项, 地方和企业委托项目20余项。获10余项重要研究成果, 其中:

★主持的7KV高压整流元件项目获1978年全国科学大会奖; 湖北省科学大会奖;

★主要参加的“环流1号”GYA24000A/3500V脉冲整流装置获国防科委1979年重大成果三等奖;

★主持的“电力半导体模块”项目获1989年湖北省科技进步二等奖;

★与襄樊仪元公司合作开发的“KK2500A/2500V晶闸管”项目获2002年湖北省科技进步二等奖。

1993年10月获国务院政府特殊津贴。2000年、2004年获华中科技大学优秀研究生指导教师, 2006年9月被评为华中科技大学师德先进个人。

近五年来从事过的主要研究任务及所负责任和作用:

① “Φ70-80mm、KK2400A、KP3000V大功率晶闸管元件”，2000—2004年，课题负责人，获湖北省科技进步二等奖。

② “大功率超高速半导体开关新结构及关键工艺技术研究”，国家自然科学基金(No.50277016) 2003—2005年，课题负责人，已结题并评为“优秀”。

③ “大功率超高速脉冲功率开关RSD关断机理研究”，教育部博士点专项基金(No.20050487044) 2006-2008年,课题负责人。

④ “XX高功率半导体闭合开关关键技术研究”（2006—2008年），国家XX项目（参与电气学院合作）

⑤ “重频高幅值脉冲功率开关RSD关断机理及透明阳极结构探索”，国家自然科学基金（No.50577028）2006-2008年，课题负责人。

⑥ 华中科技大学、浙江正邦电力电子有限公司共建浙江电力半导体器件研发基地“校企共建项目”，项目负责人。

【学术兼职】

中国电工技术学会电力电子专委会委员、中国电工技术学会电力电子学会五届、六届、七届常务理事；

武汉电源学会常务理事；

《通信电源技术》杂志编委会委员；

《电力电子技术》杂志编委会委员。

代表性论文(著作)

- [1]《半导体器件——电力、敏感、光子、微波器件》.(合编)电子工业出版社. (2000.9)
 - [2]多元胞半导体浪涌保护器转折特性与IH的折衷.华中科技大学学报.2001, 29(10): p41~43
 - [3] 半导体放电管多元胞结构模型.半导体学报.2000,21(10): 1014~1018
 - [4]RSD开关在脉冲电源中应用研究.中国电机工程学报, 2003, 23(11): 23~28
 - [5]大功率超高速半导体开关的换流特性研究. 中国电机工程学报, 2007, 27(30):38~42
 - [6]超高速半导体开关RSD的开通机理与大电流特性研究.电工技术学报, 2005, 20(2):36-40
 - [7] 基于RSD的脉冲放电系统主回路仿真与试验. 电工技术学报, 2007, 22(8):63~67
 - [8] High-power and high-speed semiconductor switch RSD applied in pulsed power system. The 7th International Conference on Power Electronics (ICPE'2007), Daegu, Korea, October 22-26, 2007, (Be included in the IEEE Xplore database)
 - [9]Mechanism Analyses on Thin Emitter Structure Improving the Turn-On Characteristics of RSD. The International Conference on Electrical Engineering 2005 (july 10-14 ,2005 Kunming China)
 - [10] Turn-on Condition and Characteristics of High-power Semiconductor Switch RSD.CES/IEEE 5th International Power Electronics and Motion Control Conference,(August 14-16,2006 Shanghai, China)p 1129~1132
 - [11]反向开关复合管的物理模型与数值方法实现. 半导体学报, 2007, 28(6): p931~937
 - [12]超高速大电流半导体开关RSD实验研究. 强激光与粒子束, 2006, 18(3): 447~450
 - [13] Study on Turn-on Mechanism and High-Current Characteristics of High-Speed Semiconductor Switch RSD. The Proceedings of The China Association for Science and Technology, 2007, 3(3): p. 124-130
 - [14] 大功率脉冲电源用超高速半导体开关RSD. 电源技术学报, 2003, 1(7): 497~500
- 申请发明专利：“一种半导体脉冲功率开关及其制备方法”.公开号：CN101013699 .

友情链接

====院系网页====

====科研单位====

====机关部处====

====子网链接====

====其他网站====

[首页](#) | [学院概况](#) | [新闻动态](#) | [党建园地](#) | [师资队伍](#) | [教务工作](#) | [科研工作](#) | [学生工作](#) | [资源中心](#) | [留言反馈](#) | [联系我们](#) | [后台管理](#)

华中科技大学 - 电子科学与技术系 | Department of Electronic Science & Technology, HUST

地址: 湖北 武汉 华中科技大学 西一楼 Tel: +86-027-87542593

版权归华中科技大学电子科学与技术系所有,信息未经允许不得转载

Powered by Estonline.net